

DAN401/DAN601/DAN801/DAN803/DAN403 DAP401/DAP601/DAP801/DAP803

エピタキシャルプレーナ形シリコンダイオードアレイ

Epitaxial Planar Silicon Diode Arrays

超高速度スイッチング用/Ultra-High-Speed Switching

● 特長

- 1) 高信頼である。
- 2) 高集積である。
- 3) 高速度 ($t_{rr}=1.5\text{ns}$ Typ.) である。
- 4) 組立ての省力化ができる。

● Features

- 1) High reliability.
- 2) High integration.
- 3) High speed (t_{rr} : 1.5ns, Typ.).
- 4) Labor saving feasible in assembly.

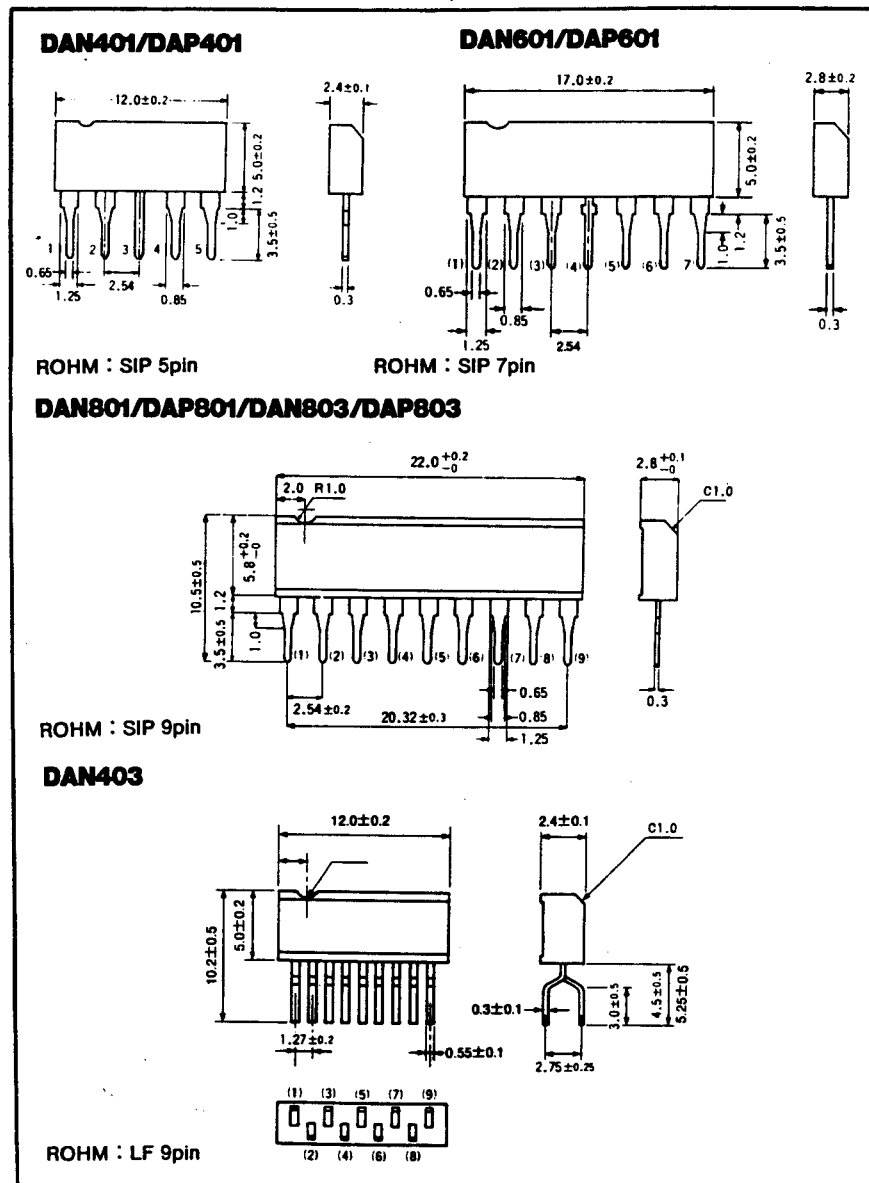
● 用途

超高速度スイッチング

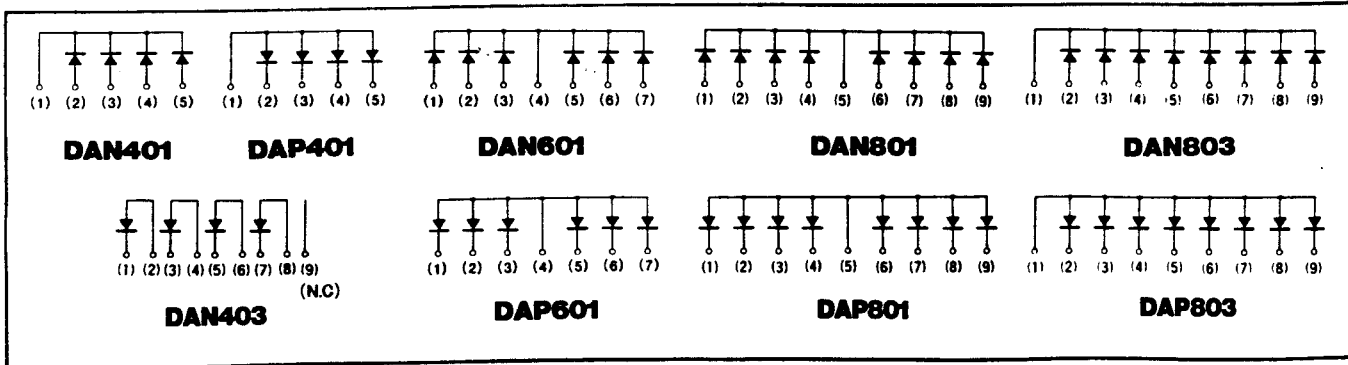
● Applications

Ultra-high-speed switching.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 等価回路図/Equivalent Circuits



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Type	尖頭 逆電圧 V _{RM} (V)	直 流 逆電圧 V _R (V)	尖頭 順電流 I _{FM} (mA)	平 均 整流電流 I _O (mA)	サージ 電流*1 I _{surge} (A)	許容 損失*2 Pd (mW)	接合部 温 度 T _J (°C)	保存温度 範 囲 T _{stg} (°C)
DAN401	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAP401	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAN601	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAP601	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAN801	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAP801	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAN803	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAP803	80	80	80	25	250	80	150	-55~150
DAN403	80	80	300	100	500	200	150	-55~150

*1 Time=1 μs

*2 パッケージあたりの値 (TOTAL)

● 電気的特性/Electrical Characteristic (Ta=25°C)

Type	順 電 圧		逆 電 流		端 子 間 容 量			逆 回 復 時 間			
	V _F (V) Max.	Cond.	I _R (μA) Max.	Cond.	C _T (pF) Max.	Cond.		t _{rr} (ns) Max.	Cond.		
		I _F (mA)		V _R (V)		V _R (V)	f (MHz)		V _R (V)	I _F (mA)	測定回路
DAN401	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP401	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAN601	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP601	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAN801	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP801	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAN803	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAP803	0.9	5	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8
DAN403	1.2	100	0.1	70	3.5	6	1	4	6	5	Fig. 8

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves (Ta=25°C)

MASTER

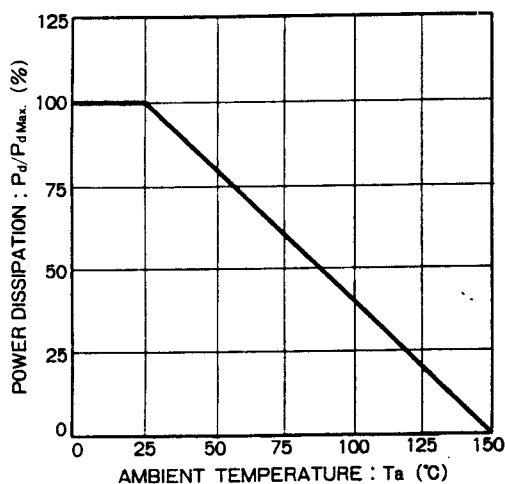


Fig.1 電力軽減曲線

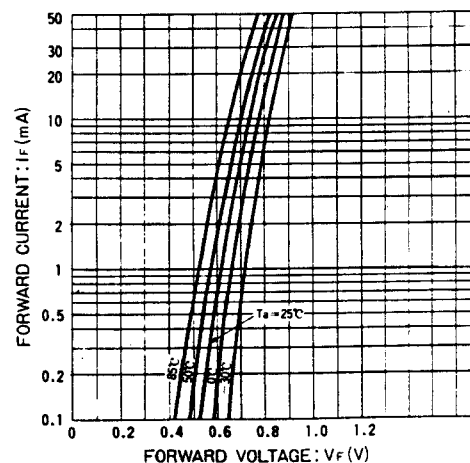


Fig.2 順電流-順電圧特性 (P TYPE)